

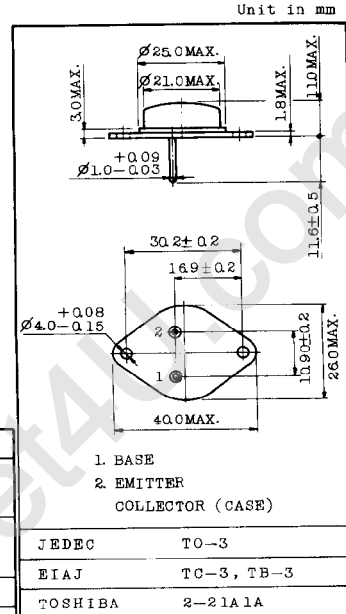
シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SB555
2SB556

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- ・ コレクタ損失が大きい。: $P_C=100W$ (2SB555, 2SB556)
- ・ 高耐圧です。: $V_{CE0}=-140V$ (2SB555)
: $V_{CE0}=-120V$ (2SB556)
- ・ 2SD425, 2SD426 とコンプリメンタリCになります。
- ・ 大電力ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
 $P_0=80W$ (2SB555), $P_0=60W$ (2SB556)
- ・ Complementary to 2SD425 and 2SD426.
- ・ Recommended for High-Power High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RATING	UNIT	
コレクタ・ベース間電圧	2SB555 2SB556	V_{CBO}	-140 -120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	2SB555 2SB556	V_{CFO}	-140 -120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V	
コレクタ電流	I_C	-12	A	
エミッタ電流	I_E	12	A	
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	P_C	100	W	
接合温度	T_j	150	°C	
保存温度	T_{stg}	-65 ~ 150	°C	



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT No. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-60V, I_E=0$	-	-	-100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	-	-	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SB555 2SB556	$V_{(BR)CEO}$ $I_C=-0.1A, I_B=0$	-140 -120	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-10mA, I_B=0$	-5	-	-	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	40	-	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	2SB555 2SB556	$V_{CE(sat)}$ $I_C=-7A, I_B=-0.7A$ $I_C=-6A, I_B=-0.6A$	-	-	-30	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	-	-	-2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	-	8	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	-	330	-	pF

Note : h_{FE} 区分/ h_{FE} classification R : 40 ~ 80, O : 70 ~ 140